(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2018年3月8日(08.03.2018)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2018/043347 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 1/62 (2012.01) *C30B 29/36* (2006.01)
C30B 25/02 (2006.01) *H01L 21/306* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2017/030578

(22) 国際出願日： 2017年8月25日(25.08.2017)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2016-167257 2016年8月29日(29.08.2016) JP

(71) 出願人: エア・ウォーター株式会社(AIR WATER INC.) [JP/JP]; 〒0600003 北海道札幌市中央区北３条西１丁目２番地 Hokkaido (JP).

(72) 発明者: 奥 秀彦(OKU, Hidehiko); 〒3998204 長野県安曇野市豊科高家２２９０番地１ エア・ウォーター株式会社内 Nagano (JP). 秀一郎(HIDE, Ichiro); 〒3998204 長野県安曇野市豊科高家２２９０番地１ エア・ウォーター株式会社内 Nagano (JP).

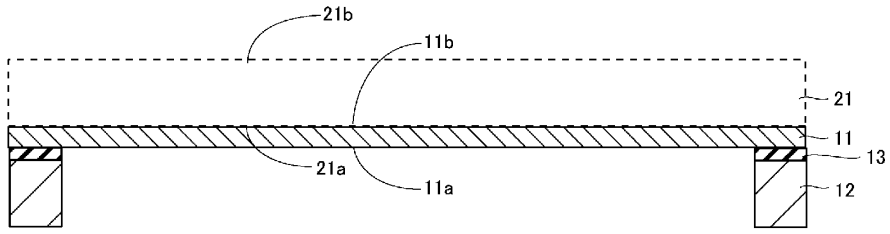
(74) 代理人: 椿 豊(TSUBAKI, Yutaka); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満３丁目１４番１６号西天満パークビル３号館９階 椿特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) **Title:** PELLICLE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称： ペリクルの製造方法



(57) **Abstract:** Provided is a pellicle production method which allows for the simplification of production steps. The pellicle production method comprises: a step for forming an SiC film (11) on a lower surface (21a) of an Si substrate (21); a step for bonding a support body (12), which includes a through hole, to a lower surface (11a) of the SiC film; and a step for removing the Si substrate after the step for bonding the support body.

(57) 要約: 製造工程の簡素化を図ることのできるペリクルの製造方法を提供する。ペリクルの製造方法は、Ｓｉ基板（２１）の下面（２１ａ）にＳｉＣ膜（１１）を形成する工程と、前記ＳｉＣ膜の下面（１１ａ）に貫通孔を含む支持体（１２）を接着する工程と、前記支持体を接着する工程の後で、前記Ｓｉ基板を除去する工程とを備える。

WO 2018/043347 A1

［続葉有］

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）